

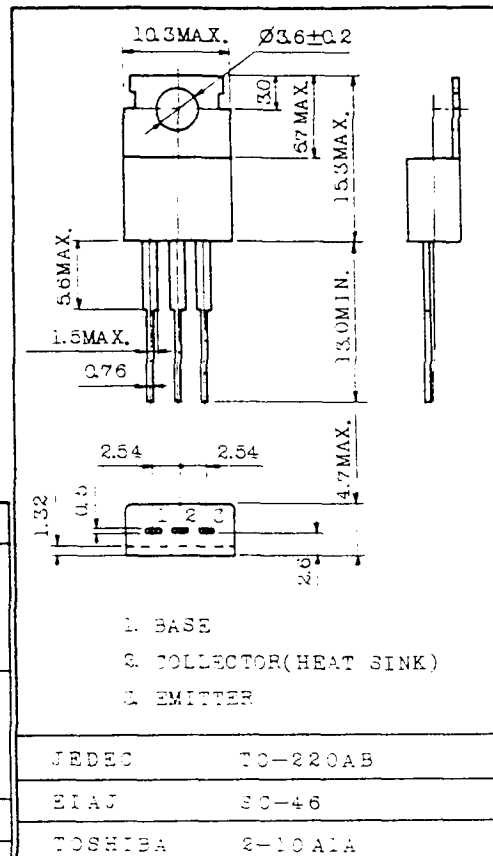
シリコンPNPエヒタキシャル形トランジスタ(PCT方式)  
SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR PCT PROCESS)

**2SA968・2SA968A**  
**2SA968B**

- 電力増幅率
- 励振段電力増幅用
- Power Amplifier Applications.
- Driver Stage Amplifier Applications.
- ・ トランジション周波数が高い。 :  $f_T=100\text{MHz}$  (Typ.)
- ・ 2SC2238 とコンプリメンタリになります。
- ・ Can Type (TO-66) の 2SA969 もあります。
- ・ Complementary to 2SC2238.

最大定格 MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	2SA968	-160	V
	2SA968A	-180	
	2SA968B	-200	
コレクタ・エミッタ間電圧	2SA968	-160	V
	2SA968A	-180	
	2SA968B	-200	
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	-5	V
コレクタ電流	$I_C$	-1.5	A
エミッタ電流	$I_E$	1.5	A
コレクタ損失 ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	$P_C$	25	W
接合温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55~150	$^\circ\text{C}$



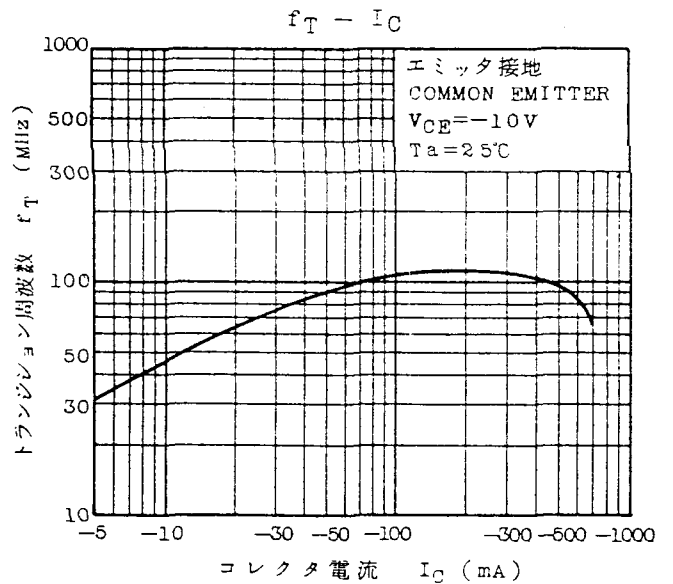
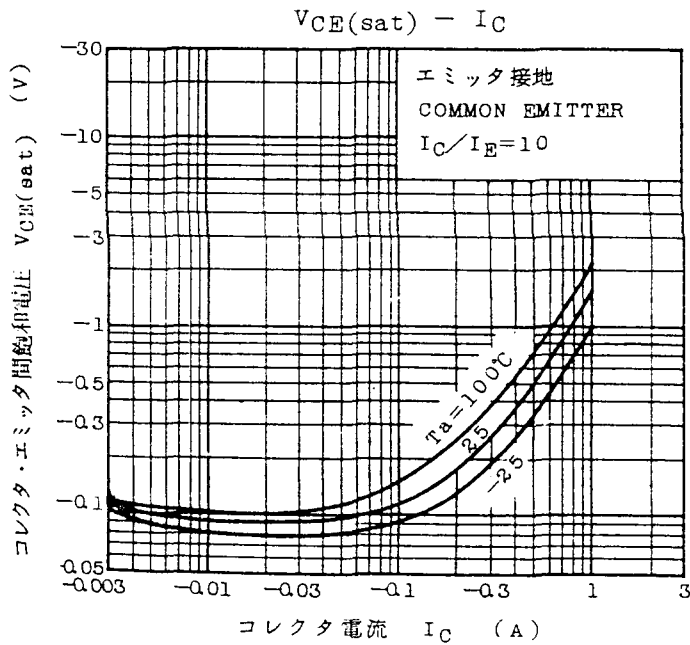
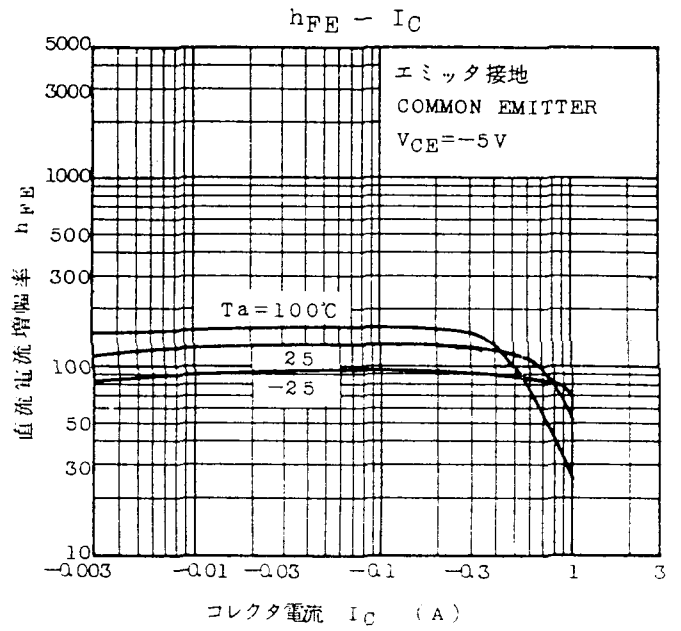
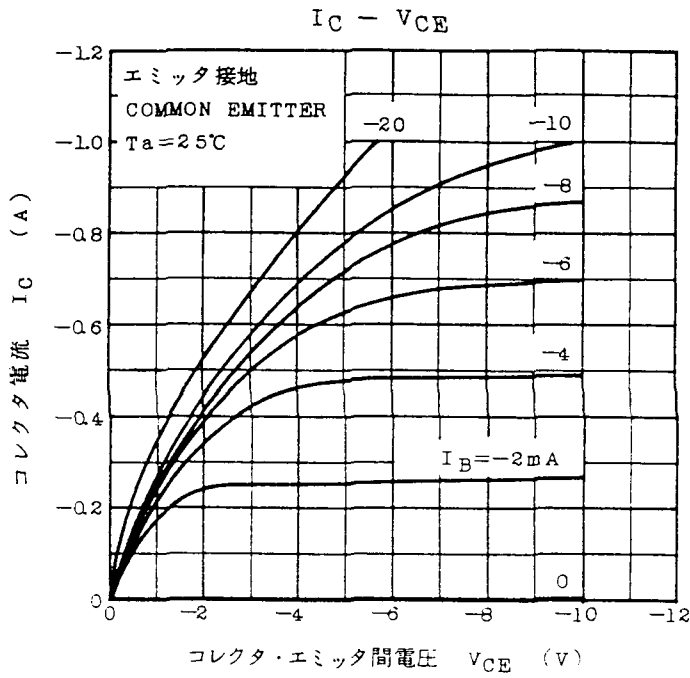
アクセサリは AC75 を適用  
MOUNTING KIT No. AC75

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=-160\text{V}, I_E=0$	-	-	-1.0	$\mu\text{A}$	
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=-5\text{V}, I_C=0$	-	-	-1.0	$\mu\text{A}$	
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=-10\text{mA}, I_B=0$	2SA968	-160	-	-	V
			2SA968A	-180	-	-	
			2SA968B	-200	-	-	
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=-1\text{mA}, I_C=0$	-5	-	-	V	
直流電流増幅率	$h_{FE}$ (Note)	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-100\text{mA}$	70	-	240		
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-500\text{mA}, I_B=-50\text{mA}$	-	-	-1.5	V	
ベース・エミッタ間電圧	$V_{BE}$	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-500\text{mA}$	-	-	-1.0	V	
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE}=-10\text{V}, I_C=-100\text{mA}$	-	100	-	MHz	
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=-10\text{V}, I_C=0, f=1\text{MHz}$	-	30	-	pF	

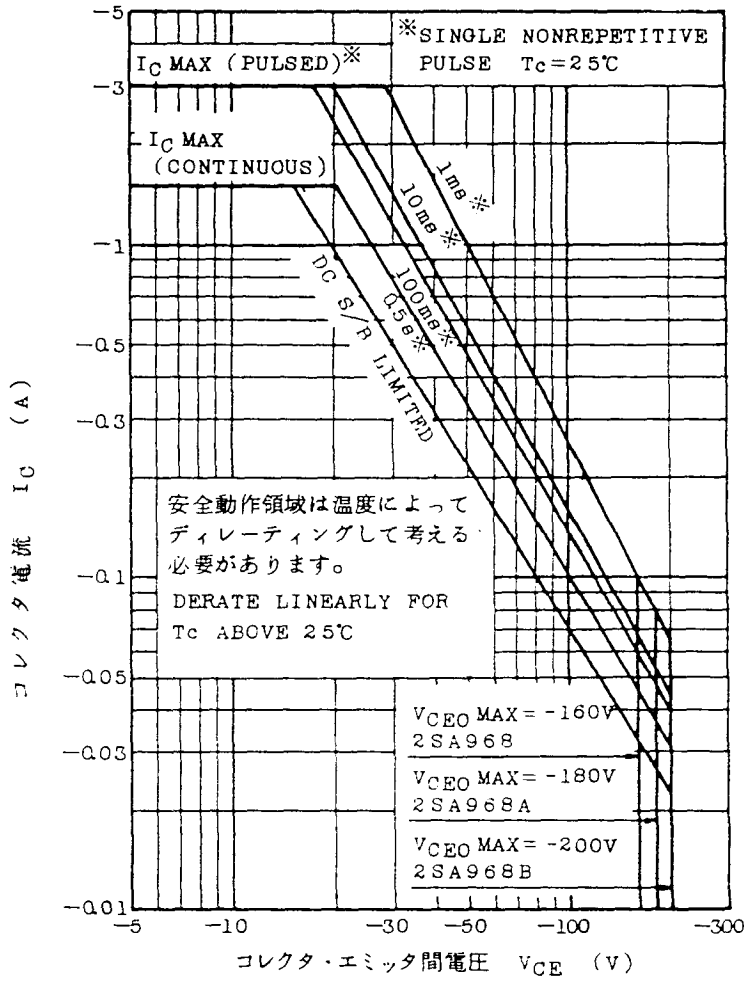
Note :  $h_{FE}$  区分 /  $h_{FE}$  classification O : 70~140, Y : 120~240

# 2SA968・2SA968A 2SA968B

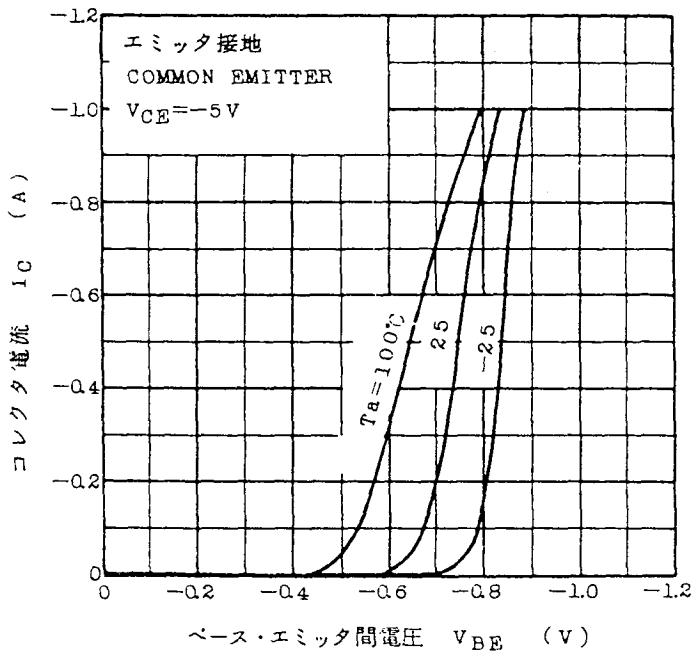


# 2SA968・2SA968A 2SA968B

## 安全動作領域 ASO



## $I_C - V_{BE}$



## $P_C - T_a$

